BEST AVAILABLE COPY

PRODUCTION OF GRANULAR AND CELLULAR CHITOSAN DERIVATIVE HAVING SULFONE GROUP

Patent number:

JP2229832

Publication date:

1990-09-12

Inventor:

FUJITA HIROYUKI; ITOYAMA MITSUNORI

Applicant:

FUJI SPINNING CO LTD

Classification:

- international:

B01J39/22; C08H5/00

- european:

Application number:

JP19890051091 19890303

Priority number(s):

JP19890051091 19890303

Report a data error here

Abstract of JP2229832

PURPOSE:To obtain a derivative capable of providing an exchange resin, etc., stable within the whole pH range and having a high strength and desired sulfone groups by dissolving low-molecular weight chitosan into an acidic aqueous solution, dripping the resultant solution into a basic solution, coagulating the above-mentioned aqueous solution, then acetylating, crosslinking and sulfonating the obtained product. CONSTITUTION:Low-molecular weight chitosan is dissolved in an acidic aqueous solution and the obtained aqueous solution is then dripped into a basic solution and coagulated to a provide granular and cellular chitosan, which is subsequently acetylated with acetic anhydride, crosslinked with a diepoxy and then sulfonated with N,N'-dimenthylformamide-sulfur trioxide complex in the N,N'- dimenthylformamide to afford a granular cellular chitosan derivative having sulfone groups. The deacetylation degree is <=10%, preferably <=5% in the course of the reaction.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-229832

5 Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)9月12日

C 08 H 5/00 B 01 J 39/22 NVF

8215-4 J 8017-4 G

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

図発明の名称

スルホン基を有する粒状多孔質キトサン誘導体の製造方法

②特 願 平1-51091

②出 願 平1(1989)3月3日

⑩発 明 者 藤田

裕之

静岡県駿東郡小山町藤曲54-1

烟発 明 者 糸

光紀

静岡県駿東郡小山町小山129-1

⑪出 願 人 富

富士紡績株式会社

東京都中央区日本橋人形町1丁目18番12号

個代 理 人 弁理士 大野 克躬 外1名

山

明細雲

1. 発明の名称

スルホン基を有する粒状多孔質キトサン誘導体の製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- 1. 低分子量キトサンを酸性水溶液に溶解し、該溶液を塩基性溶液中に落下。凝固させた粒状多孔質キトサンを無水酢酸によりアセチル化後、ジェボ

キシで架板し、次いでN.N'-ジメチルホルムアミド中でN,N'-ジメチルホルムアミドー三酸化イオウ複合体によりスルホン化することを特徴とするスルホン基を有する粒状多孔質キトサン誘導体の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明はスルホン基を有する粒状多孔質キトサン誘導体の製造方法に関し、イオン交換樹脂、クロマトグラフィー用担体等に好適な粒状多孔質キトサン誘導体を提供するものである。

【従来の技術】

キトサンのスルホン化法については従来から多くの文献等に記載があり、例えばエム・エル・ウォルフロム (H. L. Wolforn) 等の方法 (J. An. Chen. Soc., 81, 1764 (1958)) では、フレーク状のキトサンをピリジン中クロルスルホン酸で反応させるか、もしくは M. N'ージメチルホルムアミド中 M. N'ージメチルホルムアミドー三酸 化イオウ複合体による反応により、 N,0ースルホン化物を得ている。又、

ナガサワ等(Chem. Pharm. Bull., 20, 157 (1972))は改成による N-スルホン化を、特開昭 60-20362号は硫酸及びクロルスルホン酸との混合物によりβ-ロー(1→4)ーグルコサミンサでカークルカルホン化物を得ることを開示している。また粒状多孔質キトサンは、特開昭 63-274457号でヘキサメチレンジイソシアネート等で架構後ピリジンサカロルスルホン酸で N,0-スルホン化することが開テける。しかし、かかる従来方法によるを行いないは粉末キトサンにスルホン化を行なうと親水性が増大するため、水に可溶性となり

田体としての使用は不適当である。また特別的63 - 274457号の拉状多孔質キトサン誘導体のスルホン化物においては架橋を行っているが、スルホン基導入量の増加に伴う担体の劣化が起り、所望の高強度を有し、しかも高スルホン基導入量を持つ、性能の良い担体を得る事ができなかった。

【発明が解決しようとする課題】

キトサンは頻酸、酢酸、ジクロル酢酸等の水溶液に対して可溶性であるため、低pH域では損体として使用できず、安定に使用できる範囲は狭いものとなっている。又、フレーク状或いは粉末キトサンをスルホン化すると親水性が増大するため、サンをスルホンをの量を極度に少なくしなければ損体として利用しうる水不溶性のスルホン化物を得る事ができなかった。

特別昭 63 - 274457号で開示した粒状多孔質キトサン誘導体のスルホン化においては、架橋削のヘキサメチレンジイソシアネート等により架橋しているため全 pH 節域における安定性を得る事はできたが、スルホン基導入量の増加に伴う水溶性の増

解し、該溶液を塩基性溶液中に落下、凝固させた 粒状多孔質キトサンを、無水酢酸によりアセチル 化後、ジェポキシで架橋し、次いでN,N'ージメチ ルホルムアミド中においてN,N'ージメチルホルム アミドー三酸化イオウ複合体によりスルホン化す ることを特徴とするスルホン基を有する粒状多孔 質キトサン誘導体を製造する方法である。

本発明の粒状多孔質キトサンは、平均分子量
10.000~ 230.000の低分子化キトサンを用いる。
この低分子化キトサンを酢酸,ジクロル酢酸,頻
酸等の単独或いは混合物に溶解して 2~10%の水溶液となるように調整する。該キトサン水溶液を
水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリ
ウム、炭酸カリウム、アンモニア、エチレンジア
ミン等のアルカリ性物質を含む塩基性水溶液中に
0.15 mm 中孔径のノズルより圧力下で落下させる
と凝固,再生し粒状となる。得られた粒状体を充分水洗し粒状多孔質キトサンを得る。尚、塩基性水溶液中にメタノール、エタノール等のアルコール類を併用する事も可能である。

加となると共にもかが水に彫が水に彫が水に彫が水に彫が水に彫が水に彫が水に彫が水に彫が水にまるとれてもないが、大点が水にがかり、大力を推った。また、カーンをでは、大力のでは、かりでは、大力の

本発明は上述の欠点を解決し、全の間領域において安定であり、強度が高く、所望のスルホン基を有するイオン交換側脂。クロマトグラフィー用担体に好適な粒状多孔質キトサン誘導体を容易に得ることを目的としてなされた。

【課題を解決するための手段】

本発明は、低分子量キトサンを酸性水溶液に溶

上記のようにして得た粒状多孔質キトサンをアセチル化するため、これを無水酢酸と反応させて脱アセチル化度を10%以下、好ましくは 5%以下とする。アセチル化を行う際の有機溶媒は無水酢酸や反応生成物に対して不活性であり、アセチル化の反応に対し何ら影響を与えない不活性溶媒であればよく、例えばN,N'ージメチルホルムアミド, ジメチルアセトアミド, ベンゼン, 1,4ージオキサン,メタノール,エタノール,ローブタノール等を単独又は混合して使用できる。尚、この時の

等を単独又は混合して使用できる。尚、この時の脱アセチル化度が10%を越えると遊離のアミノ基がスルホン化後も多く残存してしまうため、陽イオン交換樹脂として用いる場合には、非特異吸着の問題を生じるので、脱アセチル化度は10%以下、好ましくは 5%以下である事が望ましい。

このようにして得られた脱アセチル化度が10%以下の粒状多孔質 キトサンに架橋削としてエピクロルヒドリン、エチレングリコールジグリシジルエーテル、ポリエチレングリコールジグリシジルエーテルなどのジェポキシを用い、脱アセチル化

した粒状多孔質キトサンの水酸基と反応させる方 法がとられる。その他にもヘキサメチレンジィソ シアネート、ジフェニルメタン-4,4'-ジィソシ アネート、ジカルポン酸ハロゲン化物等を使用す る方法があるが、エーテル結合により架橋される ため化学的に非常に安定である点、架橋後非常に 高強度の担体が得られる点、架橋方法が簡便であ る点からエピクロルヒドリン、エチレングリコー ルジグリシジルエーテル、ポリエチレングリコー ルジグリシジルエーテル等のジェポキシを用いる のが最適である。一方スルホン化剤としてはM,N' - ジメチルホルムアミド中に三酸化イオウを滴下 して得られるN, N'- ジメチルホルムアミド- 三酸 化イオウ複合体を用いる。その他にピリジン中ク ロルスルホン酸を使用する方法。ジクロルエタン 中クロルスルホン酸を使用する方法, N,N'-ジメ チルアニリンー無水硫酸複合体を使用する方法。 無水亜硫酸と無水硫酸の混合物を使用する方法。 硫酸とクロルスルホン酸の混合物を使用する方法 等が考えられるが、スルホン化剤が長期間安定に

【実 施 例】

以下、本発明を実施例により詳細に説明するが、本発明は実施例記載の範囲に限定されるものではない。また、スルホン基を有する粒状多孔質キトサン誘導体の陽イオン交換容量(中性塩分解能)。

キトサン酢酸水溶液の粘度, みかけの弾性率は下記のようにして求めた。

<陽イオン交換容量>

予め正確に彫酒体積を測定した試料をカラムに充塡し、約1N硝酸をSV50で通液する。純水で流出液のpHが中性を示すまでSV 100で通液し、次に約1Mの塩化ナトリウム水溶液をSV50で通液する。この時流出液はメスフラスコで正確に 1 2 期りとる。

このうちの50 nt をフェノールフタレインを指示薬 として 1/10 N- 水酸化ナトリウムで滴定を行い、 次式から関イオン交換容量 (CTV) を求めた。

CTV (
$$\mu$$
 eq \times $n\ell$) = $\frac{a \times f \times \frac{1}{10} \times \frac{1000}{50} \times 1000}{V}$

a:試験液50mlを中和するのに変した1/10 N 水酸化ナトリウム量 (ml)

「: 1/10 N水酸化ナトリウム溶液の力価

V:試料の湿潤体積(成)

< 粘 度 >

回転円筒形粘度計を用い20℃にて測定した。

くみかけの弾性率>

レオメーター NRM-2010 J-CN(不動工業株式会社製)により直径 3.5 mm. 深さ 2mmの穴に纏紙上で水を除去した試料を詰め、直径 3.0 mmの円柱状の棒で 2cm/minの速さで圧縮し、圧縮応力曲線を求め、該10%変形点での接線の傾きから求めた。実施例1.

脱アセチル化度78%のキトサン65gを 3.25 %

群肢水溶液 935gに溶解した。この時の粘度は 2.300cpであった。該溶液を 6%水酸化ナトリウム・20%エタノール・74%の水からなる混合溶液中に 0.15 mm 中の孔径のノズルから落下し、キトサンを粒状に凝固再生させた後、中性になるまや水洗し、平均粒径 0.3 mm 中の粒状多孔質キトサン 1000㎡(湿潤状態)をエタノール中12.4gの無水酢酸と 24時間空温で反応後、1N-水酸化ナトリウム水溶液で 1時間処理し、脱アセチル化度 5%の粒状多孔質キトサン80㎡を得た。

こうして得られた脱アセチル化度 5%の粒状多

孔質キトサン80㎡ (温潤状態)を 1.4-ジオキサ ンで洗浄し、 1.5gのエピクロルヒドリン 8歳の 1N-水酸化カリウム水溶液を加え室温で16時間反 応させた後、更に80℃で 1時間反応させて架橋さ せた。水洗後N,N'-ジメチルホルムアミドで洗浄 後H, N'-ジメチルホルムアミド 12中に三酸化イ オウ80gを加えたN.H'- ツメチルホルムアミドー 三酸化イオウ複合体18㎡を含むN,N'-ジメチルホ ルムアミド溶液80歳を加え、室温で 4時間反応さ せ、 N,0-スルホン化を行った。反応終了後冷却 しながら1N-水酸化ナトリウム水溶液で中和後充 分水洗し、スルホン基を有する粒状多孔質キトサ ン誘導体48㎡を得た。このものの陽イオン交換容 母は80.0μeq/mt, みかけの弾性率は 3.2×10⁶ dyn/cdであった。ここでスルホン化する際に加え るN.N'-ジメチルホルムアミド-三酸化イオウ複 合体量を18配から20配に変え、同一操作で3つの 試料を得た。3つの試料について夫々の関イオン 交換容量を測定したところ、 105.0μeq/ed. 100.8μeq/me. 102.6μeq/meであり、極めて

- 水酸化ナトリウム水溶液で中和後充分水洗し、スルホン基を有する粒状多孔質キトサン誘導体27 成を得た。このものの陽イオン交換容量は 120.5 μeq/dd, みかけの弾性率は 3.0×10⁶ dyn/ddであった。またこのスルホン基を有する粒状多孔質キトサンを 0.1H 酢酸水溶液及び 0.1H 水酸化ナトリウム水溶液に懸濁しても溶解する事なく全pH 領域で安定な損体であった。

また、上記のようにして得られた架橋反応後の粒状多孔質キトサン誘導体をスルホン化する際加えるN、N'ージメチルホルムアミドー三酸化イオウ複合体量を、 4 配、 6 配。 8 配。 12 配。 16 配と夫々変えてスルホン化を行ったところ、得られたスルホン基を有する粒状多孔質キトサン誘導体の陽イオン交換容量は、 夫々 29.2 μ eq/ 配。 71.3 μ eq/ 配。 151.0 μ eq/ 配。 228.9 μ eq/ 配。 310.0 μ eq/ 配で、それらのみかけの弾性率が夫々 3.0 μ 10 dyn/cd。 3.0 μ 10 dyn/cd。 3.0 μ 10 dyn/cd。 2.8 μ 10 dyn/cd。 2.8 μ 10 dyn/cd。 3.0 μ 10 dyn/cd。 3

再現性のよいスルホン基を有する粒状多孔質キトサンが得られることが明らかであった。得られた計 4種のスルホン基を有する粒状多孔質キトサンを、 0.1 N酢酸水溶液及び 0.1 N水酸化ナトリウム水溶液に懸濁しても全く溶解することがなく、全pH領域で安定なスルホン基を有する粒状多孔質キトサン誘導体であった。

実施 例 2.

実施例1と同様にして限アセチル化度 5%の粒状多孔質キトサンを得、その50歳(超額状態)を1,4-ジオキサンで洗浄し、1.76 gのエチレングリコールジグリシジルエーテル。 5歳の1N-水酸化カリウム溶液を加え室温で16時間反応させ来たで洗浄しド、N'-ジメチルホルムアミド12中に三酸化イオウ80gを加えたH、N'-ジメチルホルムアミドの産業で10歳を加えてきたので、100元を行った。反応終了後、冷却しながら1N

上記のN.N'ージメチルホルムアミドー三酸化イオウ複合体の添加量と得られた粒状多孔質キトサン誘導体の関イオン交換容量の関係を第1回に示した。このことからスルホン化剤の量を変える事ができ、加えてスルホン基が高導入量となった際にも担体強度があまり低下していないことが判明した。比較例1.

実施例1と同様にして得られた粒状多孔質キトサン50歳(湿潤状態)に 2.1gのヘキサメチレン ジィソシアネートを加え、N.N'ージメチルホルムアミド中室温で 1時間反応、架橋させた。N.N'ージメチルホルムアミドで洗浄後、無水ビリジンは浄した。これに氷冷した無水ビリジン 120歳中に夫々 3.40 歳。 4.55 歳のクロルスルホン酸を含む溶液を加え、沸騰湯浴中 1時間の応じ N.Oースルホン化を行った。 反応終でした。 スルホン基を有する粒状多孔質キトサンを特た。

このものの限イオン交換容別は夫々28.8μeq/ w. 72.6μeq/ w. 150μeq/ w. みかけの弾性率は 夫々 1.3×10⁶ dyn/cd. 1.3×10⁶ dyn/cd. 1.0 ×10⁶ dyn/cdであった。即ち実施例2に示した如 く本発明の方法によるスルホン基を有する粒状多 孔質キトサン誘導体は、比較例1で得られたもの に較べて強度的に 2.3~ 2.8倍の性能を有する事 が明らかである。

比较别2.

比較例 1 で示したスルホン化法において無水ビリジン 120㎡に対して加えるクロルスルホン酸量を 3㎡、 3.5㎡、 4㎡。 4.5㎡と変えてスルホン化を行ったところ、得られたものの関イオン交換で登した。またクロルスルホン酸量を 5㎡に変えて同一機作で 3 つの試料を得た。この関イオン 交換容量は失々 180.0μeq/㎡、 65.3μeq/㎡、 98.2μeq/㎡、 50.0μeq/㎡、 65.3μeq/㎡、 98.2μeq/㎡、 180.0μeq/㎡、 65.3μeq/㎡、 20 結果、比較例 1 のスルホン化法においてはスルホン化

えても所望の명イオン交換容量の多孔質粒状キト サン誘導体を得ることは容易でないことが明らか である。

【発明の効果】

本発明によって得られるスルホン基を有する粒状多孔質キトサン誘導体は全団領域においても安定であり、イオン交換樹脂、クロマトグラフィー 用担体として好適な強い強度を持つものである。

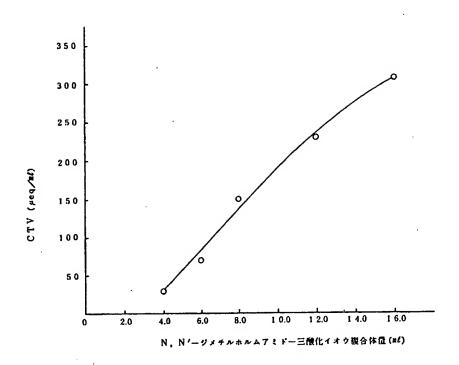
本発明のスルホン基を有する粒状多孔質キトサン誘導体は、実施例及び比較例の記載からあたいであるに、従来のスルホン化法で得られたものに、役べて全のはで安定であるはかりである。 更に本発に 2~ 3倍の性能を有するものである。 更に本発明方法においてはスルホン化剤の使用型を変えることにより、スルホン基準入量を再現性良く任意には整でき、所望の誘導体を製造することができる。

4. 図面の簡単な説明

第 1 図は、本発明の実施例 2 におけるスルホン 化剤品と関イオン交換容量との関係を示すグラフ、

第2図は、比較例2におけるスルホン化剤量と陽イオン交換容量との関係を示すグラフである。

第 1 図



第 2 図

